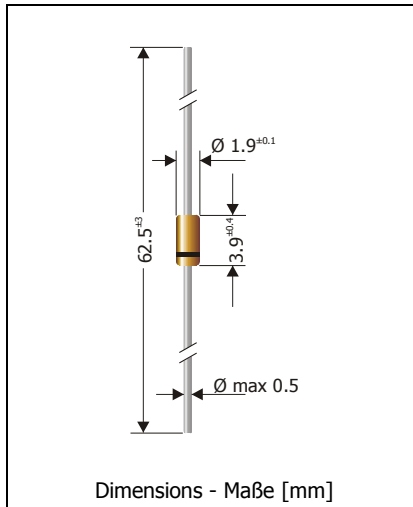


SD103A ... SD103C**Schottky Barrier Diodes
Schottky-Barrier Dioden**

Version 2012-07-03



Nominal current Nennstrom	0.2 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...40 V
Glass case Glasgehäuse	~ DO-35 ~ (SOD-27)
Weight approx. Gewicht ca.	0.13 g
Equivalent SMD-version Äquivalente SMD-Ausführung	LL103C...LL103A
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	

**Maximum ratings and Characteristics****Grenz- und Kennwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Forward voltage Durchlass-Spannung V_F [V]	
		$I_F = 20 \text{ mA}$	$I_F = 200 \text{ mA}$
SD103C	20	< 0.37	< 0.6
SD103B	30	< 0.37	< 0.6
SD103A	40	< 0.37	< 0.6

Power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	400 mW ¹⁾
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen		I_{FSM}	15 A
Leakage current, $T_j=25^{\circ}\text{C}$ Sperrstrom	SD103C $V_R = 10\text{ V}$ SD103B $V_R = 20\text{ V}$ SD103A $V_R = 30\text{ V}$	I_R	< 5 μA
Junction capacitance Sperrschichtkapazität	$V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_{tot}	typ. 50 pF
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 200\text{ mA}$ through/über $I_R = 200\text{ mA}$ to $I_R = 20\text{ mA}$	t_{rr}	typ. 10 ns
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	-50...+125 $^{\circ}\text{C}$ -50...+175 $^{\circ}\text{C}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	< 250 K/W ¹⁾

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden